

11月8日, 星期一, 下午

分会报告	A: 材料生长与表征	B: 光电子器件及应用	C: 电力电子器件及应用	D: 新型宽禁带半导体材料及应用
地点	海葵厅 (一层)	海悦1厅 (二层)	海悦2厅 (二层)	海悦3厅 (二层)
13:30   15:25	<p><b>13:30 – 13:50 邀请报告 IA-1</b>  <b>AlN 基宽禁带半导体缺陷调控及 p 型掺杂研究</b>                      黎大兵, 孙晓娟, 蒋科, 贲建伟, 张山丽                      中国科学院长春光机所                      中国科学院大学材料科学与光电工程中心</p>	<p><b>13:30 – 13:50 邀请报告 IB-1</b>  <b>量子点/氮化物半导体集成结构的 Micro-LED 器件制备与应用</b>                      刘斌, 许非凡, 余俊驰, 陶涛, 陆海, 陈敦军, 张荣                      南京大学电子科学与工程学院                      厦门大学</p>	<p><b>13:30 – 13:50 邀请报告 IC-1</b>  <b>氮化镓高功率太赫兹源</b>                      冯志红                      中国电子科技集团公司第十三研究所</p>	<p><b>13:30 – 13:50 邀请报告 ID-1</b>  <b>超宽禁带氧化镓半导体功率电子器件和光电探测器</b>                      龙世兵, 徐光伟, 赵晓龙, 孙海定                      中国科学技术大学</p>
	<p><b>13:50 – 14:10 邀请报告 IA-2</b>  <b>AlGaIn 基深紫外 LED 材料和器件研究</b>                      许福军, 沈波                      北京大学物理学院</p>	<p><b>13:50 – 14:10 邀请报告 IB-2</b>  <b>新型 GaN 外延结构及其应用</b>                      程凯                      苏州晶湛半导体有限公司</p>	<p><b>13:50 – 14:10 邀请报告 IC-2</b>  <b>面向终端应用的 GaN 射频芯片研究</b>                      马晓华                      西安电子科技大学</p>	<p><b>13:50 – 14:10 邀请报告 ID-2</b>  <b>Strategies of Enhancing Self-powered Performances in Ga2O3-based Heterojunction Photodetectors</b>                      李山, 唐为华                      北京邮电大学</p>
	<p><b>14:10 – 14:25 OA-1</b>  <b>石墨烯驱动的应力工程实现用于深紫外 LED 的无应变 AlN 薄膜的高质量外延</b>                      常洪亮, 魏同波, 王军喜, 李晋闽                      中国科学院半导体研究所</p>	<p><b>14:10 – 14:30 邀请报告 IB-3</b>  <b>Nanoscale Characterization of Surface Plasmon-Coupled Photoluminescence Enhancement in Pseudo Micro Blue LEDs Using Near-Field Scanning Optical Microscopy</b>                      李爱星, 李虞锋, 云峰                      Solid-State Lighting Engineering Research Center</p>	<p><b>14:10 – 14:25 OC-1</b>  <b>大尺寸硅基 GaN 射频器件材料外延生长研究</b>                      刘建勋, 詹晓宁, 孙秀建, 黄应南, 高宏伟, 孙钱, 杨辉                      中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所, 中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院</p>	<p><b>14:10 – 14:25 OD-1</b>  <b>厚层六角氮化硼制备、微观测量与应用</b>                      王浩敏, 吴天如, 贺立, 卢光远, 时志远                      中国科学院上海微系统与信息技术研究所</p>
	<p><b>14:25 – 14:40 OA-2</b>  <b>The preparation of low-cost and 4 inch AlN template for high performance UVC-LED</b>                      Ye Yuan, Shangfeng Liu, Lijie Huang, Jin Zhang, Tai Li, Junjie Kang, Wei Luo, Xiaoxiao Sun, Zhaoying Chen, Yongde Li, Houjin Wang, Weiyun Wang, Jason Hoo, Long Yan, Shiping Guo and Xinqiang Wang                      Songshan Lake Materials Laboratory, Peking University, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.</p>	<p><b>14:30 – 14:50 邀请报告 IB-4</b>  <b>氮化镓基 Micro-LED 巨量转移及红光芯片进展</b>                      龚政                      广东省科学院半导体研究所</p>	<p><b>14:25 – 14:40 OC-2</b>  <b>GaN 微波毫米波器件新进展</b>                      张凯, 朱广润, 代鲲鹏, 贾晨阳, 房柏彤, 李传浩, 周浩, 孙岩, 吴立枢, 程钰杰, 王伟凡, 李忠辉, 陈堂胜                      南京电子器件研究所                      南京中电芯谷高频器件产业技术研究院有限公司</p>	<p><b>14:25 – 14:40 OD-2</b>  <b>氧化镓基日盲紫外光电探测器的制备及特性研究</b>                      程其进, 徐翔宇, 陈文山, 龚彧亨, 陈文澄, 张洪良                      厦门大学电子科学与技术学院                      厦门大学化学与化学学院</p>

	<p><b>14:40 – 14:55 OA-3</b>  <b>基于高温热退火技术的半极性 AlN 外延薄膜缺陷演化研究</b>            陈荔, 郭炜, 林伟, 陈航洋, 康俊勇,            叶继春            中国科学院宁波材料技术与工程研究所            厦门大学</p>	<p><b>14:50 – 15:05 OB-1</b>  <b>用于 Micro LED 驱动的 ZnO 短沟道薄膜晶体管</b>            李思哲, 陈雪, 吴昊, 刘昌            武汉大学物理科学与技术学院人工微结构            教育部重点实验室</p>	<p><b>14:40 – 14:55 OC-3</b>  <b>硅基氮化镓外延材料射频损耗产生机理及其抑制方法</b>            马骋, 杨学林, 刘丹烁, 蔡子东,            陈正昊, 沈波            北京大学物理学院人工微结构与介观物理            国家重点实验室</p>	<p><b>14:40 – 14:55 OD-3</b>  <b>极高响应度与增益带宽积的 p 型氧化镓日盲探测器</b>            吴征远, 蒋卓汛, 马聪聪, 张浩,            叶建东, 张国旗, 康俊勇, 张统一,            方志来            复旦大学信息科学与工程学院、工程与应用            技术研究院            南京大学电子科学与工程学院            厦门大学物理科学与技术学院上海大学材            料基因组工程研究院</p>
	<p><b>14:55 – 15:10 OA-4</b>  <b>溅射中痕量氧气对高温退火 AlN 模板的极性调节作用</b>            刘志彬, 郭亚楠, 闫建昌, 曾一平,            李晋闽, 王军喜            中国科学院半导体研究所            中国科学院大学</p>	<p><b>15:05 – 15:20 OB-2</b>  <b>High Performance InGaN/GaN Visible-light Photodetectors using Polarization-induced p-type Doping</b>            吕泽升, 郭瑶, 廖钟坤, 江灏            广东省科学院半导体研究所</p>	<p><b>14:55 – 15:10 OC-4</b>  <b>常关型 GaN PNJ-HEMT 栅极漏电机理及阈值电压稳定性</b>            化梦媛, 李玲玲, 王成财, 姜作衡            南方科技大学</p>	<p><b>14:55 – 15:10 OD-4</b>  <b>基于二氧化锡的紫外光电探测器研究</b>            黎明锴, 刘伯涵, 肖兴林, 魏皓然,            刘凤新, 李强, 张兴业, 陈粤, 何云斌            湖北大学材料科学与工程学院</p>
	<p><b>15:10 – 15:25 OA-5</b>  <b>宽禁带 III 族氮化物中点缺陷单光子发射的理论研究</b>            石芝铭, 臧行, 齐占斌, 孙晓娟, 黎大兵            中科院长春光学精密机械与物理研究所            中科院大学材料科学与光电工程中心</p>	<p><b>15:20 – 15:35 OB-3</b>  <b>表面等离子元耦合对 AlGaN 基 LED 偏振特性的影响</b>            李毅, 葛梅, 朱友华, 王美玉            南通大学</p>	<p><b>15:10 – 15:25 OC-5</b>  <b>Suppression of the Regrowth Interface Leakage Current in AlGaN/GaN HEMTs by Unactivated Mg Doped GaN Layer</b>            刘婷, 渡边浩崇, 新田州吾, 王嘉, 于国浩,            安藤裕二, 本田善央, 天野浩, 田中墩之,            小出康夫            名古屋大学未来材料·系统研究所            名古屋大学电子学系            北京化工大学数理学院</p>	<p><b>15:10 – 15:25 OD-5</b>  <b>单晶氧化镓深紫外探测器</b>            赵晓龙, 穆文祥, 贾志泰, 徐光伟,            胡芹, 陶绪堂, 龙世兵            中国科学技术大学            山东大学</p>
<p><b>15:25</b>               <b>15:55</b></p>	<p><b>茶歇</b></p>			

11月8日, 星期一, 下午

分会报告	A: 材料生长与表征	B: 光电子器件及应用	C: 电力电子器件及应用	D: 新型宽禁带半导体材料及应用
地点	海葵厅 (一层)	海悦1厅 (二层)	海悦2厅 (二层)	海悦3厅 (二层)
15:55   17:55	<p><b>15:55 – 16:15 邀请报告 IA-3</b>  <b>宽禁带半导体材料中载流子调控的普适性原理探讨</b>                      黄丰                      中山大学材料学院</p>	<p><b>15:55 – 16:15 邀请报告 IB-5</b>  <b>GaN 材料碳杂质行为与激光器研究进展</b>                      赵德刚                      中国科学院半导体研究所                      中国科学院大学</p>	<p><b>15:55 – 16:15 邀请报告 IC-3</b>  <b>面向复杂电气应用环境的高可靠性 GaN 功率电子器件研究</b>                      陆海, 张荣, 郑有焘                      南京大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>15:55 – 16:15 邀请报告 ID-3</b>  <b>P 型氮掺杂β-氧化镓材料与器件初探</b>                      方志来                      复旦大学信息科学与工程学院, 复旦大学光电研究院, 工程与应用技术研究院</p>
	<p><b>16:15 – 16:35 邀请报告 IA-4</b>  <b>氮化物半导体极化工程研究</b>                      张源涛, 邓高强, 王阳, 张立东                      吉林大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>16:15 – 16:35 邀请报告 IB-6</b>  <b>硅衬底 GaN 基激光器研究进展</b>                      冯美鑫, 刘建勋, 孙钱, 杨辉                      中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所</p>	<p><b>16:15 – 16:35 邀请报告 IC-4</b>  <b>万伏级 4H-SiC 基 IGBT 器件设计与制备技术</b>                      刘延聪, 唐冠南, 汤晓燕, 袁昊, 宋庆文, 张玉明                      西安电子科技大学                      中国人民解放军空军工程大学</p>	<p><b>16:15 – 16:35 邀请报告 ID-4</b>  <b>异质集成氧化镓材料与器件</b>                      徐文慧, 王轶博, 游天桂, 胡浩东, 韩根全, 欧欣                      中国科学院上海微系统与信息技术研究所                      西安电子科技大学</p>
	<p><b>16:35 – 16:50 OA-6</b>  <b>Atomic layer deposition of AlN on 4H-SiC</b>                      Feng Zhang, Zhanwei Shen, Jun Chen                      Xiamen University, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences</p>	<p><b>16:35 – 16:55 邀请报告 IB-7</b>  <b>Lasing characteristics of GaN-based whispering gallery mode optical microcavity</b>                      Feng Yun (云峰), Peng Hu (胡朋), Yufeng Li (李虞锋), Qiang Li (李强), Ye Zhang(张烨)                      Shaanxi Provincial Key Laboratory of Photonics &amp; Information Technology, Xi'an Jiaotong University</p>	<p><b>16:35 – 16:50 OC-6</b>  <b>氮化镓单晶衬底产业发展现状和未来</b>                      吕根泉                      东莞市中镓半导体科技有限公司</p>	<p><b>16:35 – 16:50 OD-6</b>  <b>High valley polarization in monolayer WS<sub>2</sub> on AlGaN</b>                      Xu Li, Xinlong Zeng, Zhiming Wu, Yaping Wu, Junyong Kang                      Department of Physics, Xiamen University</p>
	<p><b>16:50 – 17:05 OA-7</b>  <b>液态镱氮化生长高质量氮化镱</b>                      李凯, 黄增立, 刘争晖, 徐耿钊, 韩厦, 陈科蓓, 张春玉, 宋文涛, 徐科                      中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所</p>	<p><b>16:55 – 17:15 邀请报告 IB-8</b>  <b>大功率氮化镓激光器研究进展</b>                      刘建平                      中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所</p>	<p><b>16:50 – 17:05 OC-7</b>  <b>具有高击穿电压的 AlN 背势垒 HEMT 外延材料生长</b>                      王波, 房玉龙, 高楠, 张志荣, 芦伟立, 李佳, 尹甲运, 牛晨亮, 陈宏泰                      中国电子科技集团公司第十三研究所</p>	<p><b>16:50 – 17:05 OD-7</b>  <b>超宽禁带氧化镓材料及其日盲深紫外探测器研究</b>                      李万俊, 刘浩文, 周树仁, 黄利娟, 胡郑蕊, 张红, 熊元强, 李泓霖, 叶利娟                      重庆师范大学物理与电子工程学院                      光电功能材料重庆市重点实验室</p>

	<p><b>17:05 – 17:20 OA-8</b>  <b>非极性(11-20)面 P 型 GaN 和全组分 InGaN 的 MOCVD 生长与研究</b>            赵见国, 陈凯, 胡文晓, 宫毛高, 刘斌, 陶涛, 谢自力, 严羽, 张荣, 郑有焘            南京大学电子科学与工程学院, 南京信息工程大学电子与信息工程学院, 厦门大学</p>	<p><b>17:15 – 17:30 OB-4</b>  <b>GaN 基大功率蓝光激光器</b>            梁锋, 赵德刚            中国科学院半导体研究所</p>	<p><b>17:05 – 17:20 OC-8</b>  <b>半导体用 SiC 涂层石墨托盘的制备与国产化</b>            汪洋, 万强            湖南德智新材料有限公司            南京工业大学材料科学与工程学院</p>	<p><b>17:05 – 17:20 OD-8</b>  <b>BiVO<sub>4</sub>和 WO<sub>3</sub>异质结增强 GaN 在光解水中的性能</b>            席鑫, 陈志忠            北京大学</p>
	<p><b>17:20 – 17:35 OA-9</b>  <b>等离子体密度对 ICP-MOCVD 生长 GaN 薄膜的影响</b>            余佳东, 罗毅, 王健, 张子轩, 李翔, 汪莱, 郝智彪            北京信息科学与技术国家研究中心            清华大学电子工程系</p>	<p><b>17:30 – 17:45 OB-5</b>  <b>金属双面镜高性能表面等离激元激光器及其物理机制的研究</b>            蒋迪, 陶涛, 智婷, 刘斌, 张荣, 郑有焘            江苏省光电信息功能材料重点实验室            南京邮电大学</p>	<p><b>17:20 – 17:35 OC-9</b>  <b>AlGaN 势垒层掺杂及 2DEG 沟道数对 GaN HEMTs 器件性能的影响</b>            杨旭豪, 许琦辉, 芦雪, 黄永, 陈兴, 王东            西安电子科技大学芜湖研究院            西安电子科技大学</p>	<p><b>17:20 – 17:35 OD-9</b>  <b>hBN 薄膜的磁控溅射制备及器件应用</b>            李强, 张启凡, 张浩然, 王茗迪, 云峰            西安交通大学电子科学与技术学院</p>
	<p><b>17:35 – 17:50 OA-10</b>  <b>基于水平常压式 MOCVD 的低温 p-GaN 生长与性能表征</b>            黄思溢, 池田昌夫, 张名龙, 张峰, 朱建军, 刘建平, 杨辉            中国科学院苏州纳米所            中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院</p>	<p><b>17:45 – 18:00 OB-6</b>  <b>Transverse electric lasing at record short wavelength 244.63 nm from GaN quantum wells with weak exciton localization</b>            Maocheng Shan, Yi Zhang, Xiaohang Li, Changqing Chen            Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)</p>	<p><b>17:35 – 17:50 OC-10</b>  <b>基于氮化镓金属-绝缘层-半导体高电子迁移率晶体管的单片集成 DFF-NAND 与 DFF-NOR 电路</b>            朱昱豪, 崔苗, 李昂, 方志成, 文辉清, 刘雯            西交利物浦大学智能工程学院</p>	<p><b>17:35 – 17:50 OD-10</b>  <b>基于 SiC 厚膜的极低漏电高灵敏度室温软 X 射线探测器</b>            刘清, 徐尉宗, 羊群思, 周东, 张荣, 郑有焘, 陆海            南京大学电子科学与工程学院            江苏省光电信息功能材料重点实验室</p>
<p><b>18:00</b>   <b>20:00</b></p>	<p><b>自助晚餐</b></p>			
<p><b>19:00</b>   <b>21:00</b></p>	<p><b>Poster 展示交流</b></p>			



	<p><b>09:10 – 09:25 OA-13</b>  <b>C-Related Deep Donor in P-Type GaN</b>            Huayang Huang, Xuelin Yang,            Zeming Qi, Shan Wu, Zhaohua Shen, Danshuo            Liu, Fujun Xu, Ning Tang, Xinqiang Wang,            Weikun Ge and Bo Shen            Peking University, University of            Science and Technology of China,            Collaborative Innovation Center of            Quantum Matter</p>	<p><b>09:15 – 09:30 OB-8</b>  <b>基于智能算法的深紫外 LED 效率研究方法</b>            路慧敏, 李子正, 朱一帆, 冯丽雅,            于彤军, 王建萍            北京科技大学计算机与通信工程学院            北京大学物理学院</p>	<p><b>09:10 – 09:25 OC-13</b>  <b>NiO/AlGa<sub>N</sub> interface reconstruction            and transport manipulation of p-NiO            gated AlGa<sub>N</sub>/Ga<sub>N</sub> HEMTs</b>            Hui Guo, Hehe Gong, Xinxin Yu, Rui Wang,            Qing Cai, Danfeng Pan, Jiandong Ye, Bin Liu,            Dunjun Chen, Hai Lu, Rong Zhang,            Youdou Zheng            南京大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>09:10 – 09:25 OD-13</b>  <b>Remarkable black-phase robustness            of CsPbI<sub>3</sub> nanocrystal sealed in solid            SiO<sub>2</sub>/AlO<sub>x</sub> sub-micron particles</b>            Yue Lin, Xiaotong Fan, Xiao Yang,            Xi Zheng, Weizhi Huang, Zhibin Shangguan,            Yuhan Wang, Hao-Chung Kuo, Tingzhu Wu,            Zhong Chen            Department of Electronic Science,            Fujian Engineering Research Center for            Solid-State Lighting, Xiamen University</p>
	<p><b>09:25 – 09:40 OA-14</b>  <b>面向长波长 LED 应用的石墨烯/SiC 衬底上            应变弛豫 GaN 薄膜的外延生长研究</b>            余焯, 于佳琪, 邓高强, 张宝林, 张源涛            吉林大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>09:30 – 09:45 OB-9</b>  <b>基于宽禁带铝镓氮纳米线的新型紫外光电            化学光探测器研究进展</b>            汪丹浩, 孙海定, 龙世兵            中国科学技术大学微电子学院</p>	<p><b>09:25 – 09:40 OC-14</b>  <b>具有超高光响应 (<math>3.6 \times 10^7</math> A/W) 的            AlGa<sub>N</sub>/Ga<sub>N</sub> 基光电三极管</b>            张昊宸, 孙海定, 龙世兵            中国科学技术大学微电子学院</p>	<p><b>09:25 – 09:40 OD-14</b>  <b>氧化镓基异质结日盲紫外光电探测器的制            备及性能研究</b>            吴慧珊, 吕斌, 叶志镇            浙江大学材料科学与工程学院            硅材料国家重点实验室</p>
	<p><b>09:40 – 09:55 OA-15</b>  <b>半导体核壳纳米线中光学声子的截面形状            调制</b>            薛忠贤, 屈媛, 班士良            内蒙古大学物理科学与技术学院</p>	<p><b>09:45 – 10:00 OB-10</b>  <b>金属氧化物/AlGa<sub>N</sub>/Ga<sub>N</sub> 基多异质结深紫            外光电探测器</b>            詹腾, 孙剑文, 伊晓燕, 李晋闽            中国科学半导体研究所            清华大学</p>	<p><b>09:40 – 09:55 OC-15</b>  <b>碳化硅沟槽刻蚀技术研究进展</b>            吴帆正树, 张清纯, 马宏平, 张洁,            侯欣蓝, 张园览            复旦大学工程与应用技术研究院超越照明            研究所</p>	<p><b>09:40 – 09:55 OD-15</b>  <b>高温气氛退火对体材料单晶氧化镓晶体质            量的研究</b>            武松浩, 张逸韵            北京理工大学            中国科学院半导体研究所</p>
<p><b>10:00</b>               <b>10:15</b></p>	<p><b>茶歇</b></p>			

11月9日, 星期二, 上午

分会报告	A: 材料生长与表征	B: 光电子器件及应用	C: 电力电子器件及应用	D: 新型宽禁带半导体材料及应用
地点	海棠厅 (一层)	海悦1厅 (二层)	海悦2厅 (二层)	海悦3厅 (二层)
10:15   12:15	<p><b>10:15 – 10:35 邀请报告 IA-7</b></p> <p><b>低硅三甲基铝产品的开发</b></p> <p>邢怀勇, 朱熠, 吉敏坤, 杨敏</p> <p>江苏南大光电材料股份有限公司</p>	<p><b>10:15 – 10:35 邀请报告 IB-12</b></p> <p><b>高增益 AlGaIn 基异质结紫外光电探测器及其能带的调控</b></p> <p>陈敦军, 游海帆, 王海萍, 蔡青, 陆海, 张荣, 郑有焘</p> <p>南京大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>10:15 – 10:35 邀请报告 IC-7</b></p> <p><b>GaN 基肖特基功率器件研究新进展</b></p> <p>陈鹏</p> <p>南京大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>10:15 – 10:35 邀请报告 ID-7</b></p> <p><b>全溶液法沉积柔性掺杂可控氧化铽薄膜光电器件的研究</b></p> <p>汤潇, 李晓航</p> <p>Advanced Semiconductor Lab, KAUST, Saudi Arabia</p>
	<p><b>10:35 – 10:55 邀请报告 IA-8</b></p> <p><b>PVT 法同质外延生长高质量 2 英寸 Al 极性 AlN 单晶研究</b></p> <p>李哲, 张刚, 雷丹, 黄嘉丽, 付丹扬, 王琦琨, 吴亮</p> <p>奥趋光电技术 (杭州) 有限公司</p>	<p><b>10:35 – 10:55 邀请报告 IB-13</b></p> <p><b>宽禁带半导体异质嫁接及其器件应用</b></p> <p>刘洋, 汪莱, 郝智彪, 罗毅</p> <p>清华大学电子工程系</p>	<p><b>10:35 – 10:50 OC-16</b></p> <p><b>高性能增强型氢终端金刚石 MISFET 研究</b></p> <p>何琦, 张金凤, 任泽阳, 苏凯, 邢雨菲, 梁振芳, 张进成, 郝跃</p> <p>西安电子科技大学微电子学院</p>	<p><b>10:35 – 10:55 邀请报告 ID-8</b></p> <p><b>氧化铽单晶生长与性能研究</b></p> <p>贾志泰, 穆文祥, 陶绪堂</p> <p>山东大学晶体材料国家重点实验室</p>
	<p><b>10:55 – 11:15 邀请报告 IA-9</b></p> <p><b>半极性 AlN 材料的 HVPE 生长研究</b></p> <p>张纪才, 孙茂松, 李旭, 刘婷</p> <p>北京化工大学数理学院, 广西大学物理科学与工程技术学院</p>	<p><b>10:55 – 11:15 邀请报告 IB-14</b></p> <p><b>ZnO 多元合金薄膜外延生长、带隙调控及其紫外光电探测器研究</b></p> <p>何云斌, 黎明锴, 卢寅梅, 张腾, 陈剑, 刘洋, 郭紫曼, 汪洋</p> <p>湖北大学材料科学与工程学院</p>	<p><b>10:50 – 11:05 OC-17</b></p> <p><b>4H-SiC、GaN 和 <math>\beta</math>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 巴利加优值的巨量退化</b></p> <p>程璐, 郑伟</p> <p>中山大学材料学院</p> <p>国家光电材料与技术国家重点实验室</p>	<p><b>10:55 – 11:15 邀请报告 ID-9</b></p> <p><b>氧化物半导体材料与透明电子技术</b></p> <p>吕建国</p> <p>浙江大学材料科学与工程学院</p> <p>硅材料国家重点实验室</p>
	<p><b>11:15 – 11:30 OA-16</b></p> <p><b>Carbon doping with CH<sub>4</sub> in HVPE</b></p> <p>Qiang Liu, Shuai Wang, Run Chen, Junjie Ren, Luo Li, Meimei Liu, Hongchun Ma, Genquan Lv</p> <p>Sino-Nitride Semiconductor Co. Ltd, Peking University</p>	<p><b>11:15 – 11:30 OB-11</b></p> <p><b>碳化硅(4H-SiC)紫外光电探测器研究现状</b></p> <p>杨伟锋, 吴正云</p> <p>厦门大学电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) 微电子与集成电路系</p> <p>厦门大学物理科学与技术学院物理系</p>	<p><b>11:05 – 11:20 OC-18</b></p> <p><b>室温 1.04 mA/cm<sup>2</sup> 峰值电流密度 AlN/GaN 双势垒共振隧穿二极管</b></p> <p>张赫朋, 薛军帅, 张进成, 郝跃</p> <p>西安电子科技大学微电子学院</p>	<p><b>11:15 – 11:30 OD-16</b></p> <p><b>基于 MPCVD 法异质外延生长金刚石膜的研究</b></p> <p>陈凯, 胡文晓, 叶煜聪, 刘斌, 陶涛, 张荣</p> <p>江苏省光电信息功能材料重点实验室</p> <p>南京大学电子科学与工程学院</p> <p>厦门大学</p>
	<p><b>11:30 – 11:45 OA-17</b></p> <p><b>PVT 法 AlN 单晶生长机理研究</b></p> <p>金雷, 武红磊, 程红娟, 覃佐燕</p> <p>深圳大学</p> <p>中国电子科技集团公司第四十六研究所</p>	<p><b>11:30 – 11:45 OB-12</b></p> <p><b>基于牛眼结构微腔的碳化硅单光子发射</b></p> <p>刘兴华, 刘泽森, 任芳芳, 徐尉宗, 周东, 叶建东, 张荣, 郑有焘, 陆海</p> <p>南京大学深圳研究院</p> <p>南京大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>11:20 – 11:35 OC-19</b></p> <p><b>一种通过提高界面处 sp<sup>2</sup> 碳含量改良 4H-SiC 欧姆接触的方法</b></p> <p>刘少煜, 程新红, 郑理, 刘晓博, 俞跃辉</p> <p>中国科学院上海微系统与信息技术研究所</p>	<p><b>11:30 – 11:45 OD-17</b></p> <p><b>升华法生长 <math>\beta</math> 相 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 厚膜的研究</b></p> <p>张文辉, 张赫之, 梁红伟</p> <p>大连理工大学微电子学院</p>

	<p><b>11:45 – 12:00 OA-18</b>  <b>亚稳相正交结构<math>\kappa</math>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜的异质外延研究</b>  李悦文, 修向前, 许万里, 施佳城,  朱宇霞, 张荣, 郑有焯  南京大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>11:45 – 12:00 OB-13</b>  <b>SiC 紫外单光子探测器及其成像阵列的器件物理与性能表征研究</b>  李天义, 苏琳琳, 周东, 徐尉宗,  任芳芳, 陈敦军, 张荣, 郑有焯, 陆海  南京大学电子科学与工程学院</p>	<p><b>11:35 – 11:50 OC-20</b>  <b>基于 NiO/<math>\beta</math>- Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 异质 pn 结的低漏电 JBS 二极管研究</b>  徐童龄, 罗浩勋, 邓郁馨, 陈梓敏,  裴艳丽, 卢星, 王钢  中山大学电子与信息工程学院光电材料与  技术国家重点实验室</p>	<p><b>11:45 – 12:00 OD-18</b>  <b>Band offsets and solar-blind photoresponse of <math>\epsilon</math>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/4H-SiC heterojunction</b>  Jiaying Shen, Mingfeng Gan,  Qingyi Zhang, Yangyong Tao, Zhenping Wu,  Weihua Tang  State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications &amp;  School of Science, Beijing University of Posts and Telecommunications</p>
	<p><b>12:00 – 12:15 OA-19</b>  <b>MOCVD 异质外延 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜及其相变的研究</b>  张涛, 胡志国, 程倩, 冯倩, 张雅超,  张进成  西安电子科技大学微电子学院</p>	<p><b>12:00 – 12:15 OB-14</b>  <b>A Single Chip LiFi LED with Natural White Light and Bi-Directional Communication</b>  Guozhen Liu (刘国振), Bin Guo, Yehang Cai,  Shiqiang Lu, Zhibai Zhong, Han Chen, Jun  Yin, Jing Li, Feiya Xu, Xiaohong Chen,  Junyong Kang, Duanjun Cai (蔡端俊)  Xiamen University</p>	<p><b>11:50 – 12:05 OC-21</b>  <b>光照下 AlGaIn/GaN 异质结沟道中载流子的输运过程研究</b>  柳月波, 刘红辉, 邢洁莹, 姚婉青,  戴雅琼, 杨隆坤, 王风格, 任远, 沈俊宇,  张敏杰, 吴志盛, 刘扬, 张佰君  中山大学电子与信息工程学院</p>	<p><b>12:00 – 12:15 OD-19</b>  <b>一维 ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 纳米线网薄膜材料横向制备及其光电响应研究</b>  吴雨桐, 张昆, 冯双龙, 陆文强  中国科学院重庆绿色智能技术研究院</p>
			<p><b>12:05 – 12:20 OC-22</b>  <b>基于脉冲信号导通延迟的 SiC MOSFET 结温检测方法研究</b>  姜山, 张亚民, 冯士维, 石帮兵  北京工业大学</p>	
<p><b>12:15</b>     <b>13:30</b></p>	<p><b>自助午餐</b></p>			



分会报告 E — 青年论坛  
11月8日, 星期一, 下午

海龙厅 (一层)

13:30 – 15:30		15:55 – 17:55	
13:30   13:50	<b>范德华外延氮化物异质结构与光电集成 IE-1</b> 宁静, 张进成, 郝跃 西安电子科技大学微电子学院	15:55   16:15	<b>氮化物半导体自旋调控及其器件应用 IE-7</b> 吴雅苹, 宋安柯, 吴启鹏, 林涤, 李煦, 吴志明, 康俊勇 厦门大学物理系
13:50   14:10	<b>半导体碳化硅材料中位错的基本性质研究 IE-2</b> 王蓉, 李佳君, 罗昊, 杨德仁, 皮孝东 浙江大学杭州国际科创中心 浙江大学硅材料国家重点实验室和材料科学与工程学院	16:15   16:35	<b>AlGaIn 基紫外发光和新型紫外光电化学光探测器研究进展 IE-8</b> 孙海定, 龙世兵 中国科学技术大学
14:10   14:30	<b>金刚石材料制备加工和应用研究 IE-3</b> 王希玮, 彭燕, 徐明升, 胡小波, 徐现刚 山东大学新一代半导体材料研究院	16:35   16:55	<b>半导体量子点微纳激光及其超快动力学研究 IE-9</b> 王跃 南京理工大学材料学院
14:30   14:50	<b>助溶剂法自分离制备 GaN 自支撑衬底 IE-4</b> 刘南柳, 姜永京, 王琦, 张国义 北京大学东莞光电研究院	16:55   17:15	<b>GaN 基 VCSEL 技术进展 IE-10</b> 梅洋, 郑重明, 许荣彬, 应磊莹, 龙浩, 郑志威, 张保平 厦门大学微电子与集成电路系微纳光子学研究室
14:50   15:10	<b>大面积单晶金刚石及场效应晶体管研究 IE-5</b> 王艳丰, 王玮, 常晓慧, 张晓凡, 朱天飞, 刘璋成, 陈根强, 王宏兴 西安交通大学教育部物理电子器件重点实验室 西安交通大学电子与信息学部宽禁带半导体与量子器件研究所	17:15   17:35	<b>宽禁带氮化物半导体紫外探测器研究 IE-11</b> 蒋科, 孙晓娟, 郭龙, 张山丽, 陈雨轩, 黎大兵 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 中国科学院大学材料科学与光电工程中心
15:10   15:30	<b>介稳态氧化镓薄膜的外延生长与异质集成 IE-6</b> 张文瑞 中国科学院宁波材料技术与工程研究所	17:35   17:55	<b>高灵敏石墨烯氮化镓探测器 IE-12</b> 胡安琪, 郭霞 北京邮电大学
15:30   15:55	茶歇	18:00   20:00	自助晚餐

分会报告 E — 青年论坛  
11月9日, 星期二, 上午

海龙厅 (一层)

08:00 – 09:55		10:15 – 12:15	
08:00   08:20	<b>宽禁带半导体微腔 polariton 玻色-爱因斯坦凝聚特性研究 IE-13</b> 朱海, 陈智阳, 郑湖颖, 汤梓荧, 王亚琪 中山大学	10:15   10:30	<b>第三代半导体氮化镓 (GaN) 相关专利分析报告 OE-2</b> 王鹏, 徐颖 国家知识产权局
08:20   08:40	<b>III 族氮化物极性调控在光电子及电力电子器件中的新应用 IE-14</b> 郭炜, 陈荔, 徐厚强, 戴贻钧, 林伟, 康俊勇, 叶继春 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 厦门大学	10:30   10:50	<b>全氮化镓集成器件与电路的发展与挑战 IE-18</b> 孙瑞泽, 刘超, 陈万军, 张波 电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室 电子科技大学四川省功率半导体技术工程研究中心
08:40   09:00	<b>高性能深紫外 UVC-LED 研发及应用产业化 IE-15</b> 陈景文, 吴峰, 戴江南, 陈长清 武汉光电国家研究中心, 华中科技大学 湖北深紫科技有限公司	10:50   11:10	<b>GaN 基增强型 HMET 器件关键技术 IE-19</b> 黄火林 大连理工大学光电工程与仪器科学学院
09:00   09:20	<b>基于 Micro-LED 阵列的水下双工可见光通信及水下充电系统 IE-16</b> 林润泽, 崔旭高, 田朋飞 复旦大学信息科学与工程学院	11:10   11:25	<b>高效 P 型掺杂镁源特性及外延中应用优劣分析 OE-3</b> 俞冬雷, 徐昕, 王伟, 李强强, 王宏波, 郑锐 安徽亚格盛电子新材料有限公司
09:20   09:40	<b>利用 ALD 技术改善 mini-LED 的光电与通信性能 IE-17</b> 卢霆威, 赖寿强, 潘建华, 陈金兰, 黄岳, 叶方顺, 郭浩中, 陈忠, 吴挺竹 厦门大学电子科学系 台湾阳明交通大学光电工程学系	11:25   12:15	<b>圆桌论坛</b>
09:40   09:55	<b>Optimization of AlGaN based UVC LED Structure at Prismo HiT3® OE-1</b> Long Yan, Jason Hu, Shangfeng Liu, Xinqiang Wang, Vincent Wang, Shiping Guo Advanced Micro-fabrication Equipment Inc. (China) Peking University	12:15   13:30	<b>自助午餐</b>
10:00   10:15	<b>茶歇</b>		